

（高）级职称申报人基本情况及评审登记表

姓名	王硕培	性别	男	出生	1991年3月	参加工作时间	2019年4月	现工作单位	松山湖材料实验室	现任行政职务	无						
何时毕业于何院校何专业	2019年1月6日毕业于中国科学院大学凝聚态物理专业		本专业最高学历	研究生	学位	博士	办学形式	全日制	现职称专业及名称	物理助理研究员	现职称获得方式	考核认定	现职称获得时间	2020.05.19	现职称发证单位	东莞市人力资源和社会保障局	
现从事何专业技术工作	凝聚态物理	现受聘何专业技术职务	凝聚态物理专业研究人员	从事本专业或相近专业技术工作			6年	申报何职称	凝聚态物理专业副研究员职称		有无同时或不同时申报其他系列（专业）职称及其名称			无			
职称外语考试						全国计算机应用能力考试				专业实践能力考试（考评结合专业填写）							
已获得无级别合格证	成绩无分，属所报职称无要求倾斜范围	考试时间	属所报职称无要求免试范围			已获得无个模块合格证	属所报职称无要求政策倾斜范围			考试专业	考试成绩	考试时间	无				
主要工作经历	2019年4月至2023年1月 在松山湖材料实验室工作，担任岗位博士后； 2023年1月至今 在松山湖材料实验室工作，担任高级工程师。																
专业技术工作经历（能力）及业绩成果情况	<p>本人自评认为具备专业技术工作经历（能力）条件第 <u>1、2、(1)、3</u> 项、业绩成果条件第 <u>1、(1)(3)(4)</u> 项之规定，自选代表性成果第 <u>1、3、4</u> 项。</p> <p>主要理由</p> <p>一、工作能力（经历）条件： 符合“从事基础研究工作的”专业技术人员工作能力（经历）条件。</p> <p>1. 本人具备扎实的物理、材料与微电子学科理论基础，长期从事二维半导体材料的可控制备、新型器件等前沿领域研究。具有敏锐的国际化科研视野，能够准确把握国内外技术演进趋势，并始终以国家电子信息战略与地方产业需求为导向开展科学研究，具备解决复杂学术问题的能力。</p> <p>2. 申报人在工作中过程中积累了丰富的科研经验，主持国家自然科学基金青年基金1项（在研），主持广东省基础与应用基础研究基金青年基金项目1项（已结题），作为项目骨干参与国家重点研发计划项目1项（在研），在国际学术期刊上发表了多篇具有创新性的科研论文，并作为主要发明人授权中国发明专利3项；</p> <p>3. 参加工作以来，协助课题组长指导多名研究生的工作。其中已毕业博士研究生1名，硕士研究生1名，目前均进入学术研究领域及工业领域进一步深造。目前，协助培养在读研究生2名，开展相关研究课题，辅导完成学位论文设计与撰写。</p> <p>二、业绩成果条件： 任现职期间符合第1项“从事基础研究工作的”专业技术人员业绩成果条件：</p> <p>1. 符合第（1）项之规定。主持完成省（部）级科研项目1项。具体如下： （1）广东省基础与应用基础研究基金青年基金项目，2020年1月-2022年12月，晶圆级二维材料可控制备及范德华异质结研究，项目负责人，已结题。</p> <p>2. 符合第（3）项之规定。作为主要完成人获得授权发明专利2项。具体如下： （1）《一种硒辅助干法转移晶圆尺寸二维半导体薄膜的方法》，ZL202510030185.9，2025年10月3日； （2）《晶圆级过渡金属硫属化合物及其制备装置和方法》，ZL202410112027.3，2025年10月28日。</p> <p>3. 符合第（4）项之规定。共发表学术论文2篇，其中第一作者1篇（SCI 1篇），通讯作者1篇（其中SCI 1篇）。</p> <p>三、代表性成果： 本人自选取得现职称以来代表性成果为第1、3、4项。</p> <p>1. 第1项：主持完成的与本专业项目的科研项目。 申报人已主持完成广东省基础与应用基础研究基金青年基金项目1项，并通过验收。 项目名称：晶圆级二维材料可控制备及范德华异质结研究 执行时间：2020年1月-2022年12月</p> <p>2. 第3项：作为主要完成人，获得与本专业相关且已授权的发明专利或实用新型专利。 申报人主要完成人，获得与本专业相关且已授权的发明专利2项。 （1）《一种硒辅助干法转移晶圆尺寸二维半导体薄膜的方法》，发明专利授权号：ZL202510030185.9，授权日：2025年10月3日； （2）《晶圆级过渡金属硫属化合物及其制备装置和方法》，发明专利授权号：ZL202410112027.3，授权日：2025年10月28日。</p> <p>3. 第4项：作为第一作者在高水平专业学术期刊上发表的学术论文。 论文题目：Wafer-Scale Growth of Monolayer MoSe₂ via Salt-Assisted Chemical Vapor Deposition. 期刊信息：Small Methods, 2025, 9(9): e00914. 主要内容：单层二硒化钼具有窄的直接带隙和强自旋轨道耦合特性，是下一代电子器件的理想半导体材料，但实现高质量、大面积的规模化制备及清洁转移仍面临挑战。我们采用盐辅助化学气相沉积技术，以钼酸钠作为液相前驱体，结合紫外线衬底预处理，成功在蓝宝石上实现了2英寸晶圆级单层二硒化钼的外延生长。由于液相前驱体能显著降低生长过程中的动力学能垒并提供均匀的反应界面，单个单晶畴尺寸可达120 μm，且薄膜展现出极高的结晶度（PL强度是传统固源法的14.5倍）。得益于自主开发的纯去离子水辅助转移工艺，有效避免了化学残留对材料性能的损害。基于该薄膜构筑的场效应晶体管展现出优异的电学性能，载流子迁移率高达39.1 cm² V⁻¹ s⁻¹，电流开关比达到10⁸至10¹⁰。该策略为高质量二维过渡金属硫族化合物的规模化合成及集成电路应用提供了重要参考。该工作发表于纳米技术与材料领域知名期刊《Small Methods》。</p>																
本人对负面工作的说明：无																	
提交论文、著作或	标题内容	作者名次	何时发表何刊物杂志			刊号	获奖情况（何部门批准及奖励名称、等级）										
	Wafer-Scale Growth of Monolayer MoSe ₂ via Salt-Assisted Chemical Vapor Deposition	共同第一	2025年8月第9卷第9期《Small Methods》			ISSN 2366-9608											
	Chemical Vapor Deposition of 4 Inch Wafer-Scale Monolayer MoSe ₂	共同通讯	2022年11月第2卷第11期《Small Science》			ISSN 2688-4046											

评 情 公 示	经公示，无异议。 年 月 日(公章)				单 位 审 核 评 价 意 见				
	本人承诺：以上所填写及提交的材料内容真实，并对此负责和承担相应后果。 申报人签名：年 月 日								
	以上填写的内容，已经我单位核对无误，并对此负责和承担相应后果。 单位负责人签名：年 月 日 公章					单位负责人签名：年 月 日 公章			
专业学科组评审情况	学科组人数	到会人数	同意票	不同意票	评委会评审结果	评委会人数	到会人数	同意票	不同意票

说明：1、此表由申报人填写后用 A3 纸打印，经单位审核盖章（一式 2 份原件）送评委会办公室。2、“现职称取得方式”指评审、考核认定、考试。
3、单位审核评价意见字数不少于 150 字。4、此表供评委会评审时了解申报人基本情况之用。

()评委会公章：

年 月 日